PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **05127361** A

(43) Date of publication of application: 25 . 05 . 93

(51) Int. Cl G03F 1/08

H01L 21/027

(21) Application number: 03287832

(22) Date of filing: **01** . **11** . **91** (72) Inventor:

(71) Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(72) Inventor: MIYASHITA HIROYUKI ISHIKITA SACHIKO

MIKAMI TAKEKAZU

(54) HALFTONE PHASE SHIFT PHOTOMASK

(57) Abstract:

PURPOSE: To further simplify structure and to further facilitate production.

CONSTITUTION: A phase shift layer 11 also acting as a halftone light shielding layer is formed on the surface of a transparent substrate 10 with a material having a uniform compsn. in accordance with a prescribed pattern. The thickness (d) of the phase shift layer 11 is regulated to $d_{\infty}\lambda[2(n-1)]$ [λ is wavelength used and (n) is the refractive index of the layer 11] or odd times as large as $\lambda[2(n-1)]$ and the transmissivity of the layer 11 is regulated to about 5-30%.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

~10 ~10 (19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-127361

(43)公開日 平成5年(1993)5月25日

(51) Int. Cl. s 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 G03F 1/08 A 7369-2H L 7369-2H H01L 21/027 7352-4M H01L 21/30 審査請求 未請求 請求項の数4 (全6頁) 特願平3-287832 (21)出願番号 (71)出願人 000002897 大日本印刷株式会社 (22)出願日 平成3年(1991)11月1日 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (72)発明者 宮下裕之 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大 日本印刷株式会社内 (72)発明者 石北幸子 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大 日本印刷株式会社内 (72)発明者 三上豪一 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大 日本印刷株式会社内 (74)代理人 弁理士 韮澤 弘 (外7名)

(54) 【発明の名称】ハーフトーン位相シフトフオトマスク

(57)【要約】

【目的】 構造をさらに単純化し、製造をより容易化したハーフトーン位相シフトフォトマスク。

【構成】 透明基板 10 と、その表面に所定のパターンに従って設けられた均一組成材料からなるハーフトーン遮光層兼位相シフト層 11 とからなり、ハーフトーン遮光層兼位相シフト層 11 は、使用波長を λ 、その屈折率を n とするとき、膜厚 d が、ほぼ d = λ / $\{2$ (n-1) 】 又はその奇数倍になるように設定され、また、その透過率がほぼ 5 \sim 3 0 %の範囲になるように構成されている。

///////////////////////////////////////	V/////////////////////////////////////	 ~ 11
		~10

20

30

40

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板と、その表面に所定のバターンに従って設けられた均一組成材料からなるハーフトーン遮光層兼位相シフト層とからなり、該ハーフトーン遮光層兼位相シフト層は、使用波長を入、その屈折率を n とするとき、膜厚 d が、ほぼ d = λ / {2 (n-1)} 及はその奇数倍になるように設定され、また、その透過になるように構成されていることを特徴とするハーフトーン値相シフトフォトマスト層が、 C r O 、 C 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O 、 N 、 C で O に N が で 項1記載のハーフトーン位相シフトフォトマスク。

【請求項3】 前記ハーフトーン遮光層兼位相シフト層が、透明な無機物又は有機物中に顔料又は染料を分散させて構成されていることを特徴とする請求項1記載のハーフトーン位相シフトフォトマスク。

【請求項4】 前記ハーフトーン遮光層兼位相シフト層が、スピン・オン・グラスに遮光性微粒子を分散させたものから構成されていることを特徴とする請求項3記載のハーフトーン位相シフトフォトマスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSI、超LSI等の高密度集積回路の製造に用いられるフォトマスクに係わり、特に、微細なパターンを高精度に形成する際に用いられるハーフトーン位相シフトフォトマスクに関する。 【0002】

【従来の技術】IC、LSI、超LSI等の半導体集積回路は、Siウェーハ等の被加工基板上にレジストを塗布し、ステッパー等により所望のパターンを露光した後、現像、エッチングを行う、いわゆるリソグラフィー工程を繰り返すことにより製造されている。

【0003】 このようなリソグラフィー工程に使用されるレチクルと呼ばれるフォトマスクは、半導体集積回路の高性能化、高集積化に伴ってますます高精度を要求される傾向にあり、例えば、代表的なLSIであるDRAMを例にとると、1 MビットDRAM用の5 倍レチクル、すなわち、露光するパターンの5 倍のサイズを有するレチクルにおける寸法のずれは、平均値 $\pm 3\sigma$ (σ は標準偏差)をとった場合においても、 0.15μ mの精度が要求され、同様に、4 MビットDRAM用の5 倍レチクルは、 $0.1\sim0.15\mu$ mの寸法精度が、16 MビットDRAM用5 倍レチクルは $0.05\sim0.1\mu$ mの寸法精度が要求されている。

【0004】 さらに、これらのレチクルを使用して形成されるデバイスパターンの線幅は、1 MビットDRAMで 1.2μ m、4 MビットDRAMでは 0.8μ m、1 6 MビットDRAMでは 0.6μ mと、ますます微細化が要求されており、このような要求に応えるために様々

な露光方法が研究されている。

【0005】ところが、例えば64MビットDRAMクラスの次々世代のデバイスパターンになると、これまでのレチクルを用いたステッパー露光方式ではレジストバターンの解像限界となり、例えば特開昭58-173744号公報、特公昭62-59296号公報等に示されているような位相シフトマスクという新しい考え方のレチクルが提案されてきている。この位相シフトレチクルを用いる位相シフトリソグラフィーは、レチクルを透過10 する光の位相を操作することによって、投影像の分解能及びコントラストを向上させる技術である。

2

【0006】このような位相シフトマスクの1つとして、ハーフトーン位相シフトフォトマスクが提案されている。このハーフトーン位相シフトフォトマスクを図面に従って簡単に説明する。図3はハーフトーン位相シフトリソグラフィーの原理を示す図、図4は従来法を示す図、図4は従来法を示す図、図3(a)及び図4(a)はレチクル上の光の版幅、図3(c)及び図4(c)はウェーハ上の光の振幅、図3(d)及び図4(d)はウェーハ上の光強度をそれぞれ示し、1は基板、2は100%遮光膜、3は5~30%の透過率のハーフトーン遮光膜、4は位相シフト層、5は入射光を示す。

【0007】従来法においては、図4(a)に示すよう に、石英ガラス等からなる基板1にクロム等からなる1 00%遮光膜2が形成されて、所定のパターンの光透過 部が形成されているだけであるが、ハーフトーン位相シ フトリソグラフィーでは、図3(a)に示すように、遮 光膜をハーフトーン遮光膜3で形成し、ハーフトーン遮 光膜3上に位相を反転(位相差180°)させるための 透過膜からなる位相シフト層4が設けられている。した がって、従来法においては、レチクル上の光の振幅は図 4 (b) に示すように同相となり、ウェーハ上の光の振 幅も図4(c)に示すように同相となり、マスクの開口 部から外側へ裾広がりに分布するので、その結果、図4 (d) のようにウェーハ上の光強度分布はマスクパター ンに対応した形状にはならないで、マスク開口部から外 側へ裾広がりの分布になる。これに対して、ハーフトー ン位相シフトリソグラフィーにおいては、ハーフトーン 遮光膜3及び位相シフト層4を透過した光は、図3

(b) に示すように、開口部を透過した光と逆位相になるため、パターンの境界部で光強度が零になり、図4 (d) に示すように、光強度分布の裾広がりを抑えることができる。このように、ハーフトーン位相シフトリソグラフィーにおいては、従来は分解できなかったパターンも分解可能となり、解像度を向上させることができるものである。

【0008】次に、これまでに提唱されているハーフトーン位相シフトフォトマスクの製造方法について説明す50 る。図5はその製造工程を示す断面図であり、図中、1

10

3

9は基板、20は導電層、21はハーフトーン遮光層、 22は位相シフト層、23はレジスト、24はレジスト パターン、25はエッチングガス、26はハーフトーン 遮光パターン、27は位相シフターパターンを示してい る。

【0009】まず、図5(a)に示すような常法に従っ て作製し、欠陥検査したハーフトーン位相シフトフォト マスクプランクス上に、同図(b)に示すように、クロ ロメチル化ポリスチレン等の電離放射線レジスト23を スピンコーティング等の常法により均一に塗布し、加熱 乾燥処理を行う。加熱乾燥処理は、使用するレジストの 種類にもよるが、通常、80~150℃で20~60分 問行う。次に、レジスト層23に、常法に従って電子線 描画装置等の露光装置によって電離放射線でパターン描 画し、エチルセロソルプやエステル等の有機溶媒を主成 分とする現像液で現像後、アルコールでリンスして、同 図(c)に示すようなレジストパターン24を形成す る。

【0010】次に、必要に応じて加熱処理、及び、ディ スカム処理を行ってレジストパターン24のエッジ部分 に残存したレジスト屑、ヒゲ等の不要なレジストを除去 した後、同図(d)に示すように、レジストパターン2 4の開口部より露出する被加工部分、すなわち、位相シ フト層22及びハーフトーン遮光層21をエッチングガ スプラズマ25の条件変更によって連続してドライエッ チングし、ハーフトーン遮光パターン26及びシ位相シ フターパターン27を形成する。なお、このハーフトー ン遮光パターン26、位相シフターパターン27の形成 は、エッチングガスプラズマ25によるドライエッチン グに代えて、ウェットエッチングにより行ってもよいこ とは、当業者間では明らかなことである。

【0011】この後、レジストパターン24すなわち残 存するレジストを溶剤剥離し、フォトマスクとする。こ のフォトマスクを洗浄後、検査し、同図(e)に示すよ うに位相シフターパターン27を有するハーフトーン位 相シフトフォトマスクが完成する。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の ような従来のハーフトーン位相シフトフォトマスクにお いては、位相シフト層、ハーフトーン遮光層の2層を形 成する必要があり、ブランクス製造工程数が増加する。 また、ハーフトーン遮光層、位相シフト層のエッチング 条件が異なる等マスク製造プロセスも増加する。欠陥検 査も、ハーフトーン遮光層、位相シフト層それぞれにつ いて行う必要がある。これらのため、高コスト化、製造 期間の長期化、欠陥の多発等、多くの問題を含んでい

【0013】本発明はこのような状況に鑑みてなされた ものであり、その目的は、構造をさらに単純化し、製造 を提供することである。

s'.

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の問題に 鑑み、実用的で精度が高くかつ製造がより容易なハーフ トーン位相シフトフォトマスクを開発すべく研究の結 果、ハーフトーン遮光膜と位相シフト層を1層で構成で きることを見出し、かかる知見に基づいて本発明を完成 したものである。

【0015】すなわち、本発明のハーフトーン位相シフ トフォトマスクは、透明基板と、その表面に所定のパタ ーンに従って設けられた均一組成材料からなるハーフト ーン遮光層兼位相シフト層とからなり、該ハーフトーン 遮光層兼位相シフト層は、使用波長を入、その屈折率を nとするとき、膜厚dが、ほぼd = λ / {2 (n -1) } 又はその奇数倍になるように設定され、また、そ の透過率がほぼ5~30%の範囲になるように構成され ていることを特徴とするものである。

【0016】この場合、ハーフトーン遮光層兼位相シフ ト層は、CrO,、CrN,、CrO, N,、CrO, N, C. の何れかから構成するか、透明な無機物又は有 機物中に顔料又は染料を分散させて構成することができ る。後者の場合、例えば、ハーフトーン遮光層兼位相シ フト層を、スピン・オン・グラスに遮光性微粒子を分散 させたものから構成することができる。

[0017]

30

【作用】本発明においては、ハーフトーン位相シフトフ オトマスクを、透明基板と、その表面に所定のパターン に従って設けられた均一組成材料からなるハーフトーン 遮光層兼位相シフト層とから構成するので、構成が極め て単純であり、製造に関しても工程数削減により、欠陥 の発生が押さえられ、同時に、製造コストを低く押さえ ることも併せて可能となる。そして、それにもかかわら ず、ハーフトーン位相シフトフォトマスクの特長である 通常のフォトマスクでは得られない高分解能が可能とな る。

[0018]

【実施例】以下、本発明のハーフトーン位相シフトフォ トマスクの1実施例を図1を参照にして説明する。図1 は、本発明に係わるハーフトーン位相シフトフォトマス ク(レチクル)の断面図であり、このフォトマスクは、 石英基板10と、その表面に所定のパターンに従って設 けられたハーフトーン遮光層兼位相シフト層11とから なっている。ハーフトーン遮光層兼位相シフト層11 は、使用波長を入、その屈折率をnとするとき、膜厚d が、 d = λ / {2 (n-1)} 又はその奇数倍になるよ うに設定され、また、その透過率が5~30%であるよ うに構成されている。具体的には、ハーフトーン遮光層 兼位相シフト層11は、例えば、クロムをスパッタリン グのターゲットとし、蒸着雰囲気中に酸素等のガスを入 をより容易化したハーフトーン位相シフトフォトマスク 50 れて、CrO,、CrN,、CrO,N,、CrO,N

5

, C. 等のクロムの酸化物、窒化物、酸窒化物、酸窒炭化物を基板10上に堆積することにより形成されるが、成膜条件を変えてクロムの酸素等に対する含有量を制御して、上記膜厚条件と透過率条件の両者を満足するように構成される。

【0019】したがって、図3を参照にして説明したように、このような構成のハーフトーン位相シフトフキーできな、で、では、光強度分布の裾広がりを抑えることができなかった微細パターンも分解できなかった微細パターンも分解なようでも、図1の断面図から明らかなように単一のハーフトーンを選びませる。しかも、図1の断面図から明らかなようにといる。しかも、図1の断面図から明らかなようにといを狙して、とす来り位は、基板10上に単一のハーフトの上にレジストはを10元とによりができると言う最も基本的なリソグできると言う最も基本的なリソグできる。

【0020】なお、ハーフトーン遮光層兼位相シフト層 11は、クロムの酸化物等により構成する代わりに、透明な無機物、有機物中に顔料、染料を分散させて上記透過率条件及び膜厚条件を満足するようにして構成することもできる。

【0021】次に、その1例として、スピン・オン・グ ラス(SOG)によりハーフトーン遮光層兼位相シフト 層を作成する場合の実施例を示す。図2はこの場合の製 造工程を示す断面図であり、まず、同図(a)に示すよ うなハーフトーン位相シフトフォトマスクプランクを用 意する。図中、39は基板、40は導電層、41はハー フトーン遮光層兼位相シフト層(厚さは例えばi線に対 して約405nmで、180°位相シフターを構成し、 透過率は5~30%の範囲)を示す。ハーフトーン遮光 層兼位相シフト層41は、SOG溶液にカーポン、Si N, 、Si等の遮光性微粒子(粒子径:数~数十nm) を分散法により混合し、スピンコート、焼成して作成す る。混合するカーボ等の遮光性微粒子の量は、焼成した 基板の透過率をモニターしながら加減する。また、超音 波処理等を適宜行い、均一に混合する。透過率は、上記 のように5~30%の範囲で選択されるが、1例として カーボン微粒子を用いて約16%となるようにした。

【0022】次いで、このようなハーフトーン位相シフトフォトマスクブランクの欠陥検査を行い、同図(b)に示すように、その上に、クロロメチル化ポリスチレン等の電離放射線レジスト42をスピンコーティング等の常法により均一に塗布し、加熱乾燥処理を行う。加熱乾燥処理は、使用するレジストの種類にもよるが、通常、80~150℃で20~60分間程度行う。次に、レジスト層42に、常法に従って電子線描画装置等の露光装置によって電離放射線でパターン描画し、エチルセロソルプやエステル等の有機溶媒を主成分とする現像液で現50

像後、アルコールでリンスし、同図(c)に示すような レジストパターン43を形成する。

【0023】次に、必要に応じて加熱処理、及び、ディスカム処理を行ってレジストパターン43のエッジお除さした残存したレジスト屑、ヒゲ等の不要なレジストをした後、同図(d)に示すように、レジストパターン43の開口部より誘出する被加工部分、すなわち、ハーフラーン遮光層兼位相シフト層41をエッチングガスプラスマ44によりドライエッチングし、ハーフトーンフターパターン45を形成する。なお、このシフターパターン45を形成する。なお、プラズマ44によりテーン45の形成は、エッチングガスプラズマ44によるドライエッチングに代えてウェットエッチングによるドライエッチングに代えてウェットエッチングにより行ってもよいことは当業者間では明らかなことである。

【0024】この後、同図(e)に示すように、レジストパターン43すなわち残存するレジストを溶剤剥離し、フォトマスクとする。このフォトマスクを洗浄後、検査し、ハーフトーン位相シフターパターン45を有するハーフトーン位相シフトフォトマスクが完成する。

【0025】このように、カーボン微粒子を分散して透過率が約16%となるようにしたSOGからなるハーフトーン位相シフターパターンの場合、フォトマスクブランクスの透過率は、平均値± 3σ (σ は標準偏差)をとった場合に±0. 8%であった。また、このように工程数の少ないプロセスで製造したハーフトーン位相シフォトマスクのハーフトーン位相シフターの位置ずれは、平均値± 3σ (σ は標準偏差)をとった場合に、±0. 1μ m以内という値を示し、高精度のハーフトーン位相シフトフォトマスクが得られたことが確認され、パターン歪み等は全く観測されなかった。

[0026]

30

【発明の効果】最近のLSI、超LSIの高集積化に伴い、ますますフォトマスクの高精度化が要求され、マスク構成も複雑化し、それに従って、工程数の増加、ゴミ等による欠陥の多発が問題になっている。また、必然的に高コストとなる。

【0027】本発明においては、上記したように、ハーフトーン位相シフトフォトマスクを、透明基板と、その表面に所定のパターンに従って設けられた均一組成材料がらなるハーフトーン遮光層兼位相シフト層とから構成するので、構成が極めて単純であり、製造に関しても工程数削減により、欠陥の発生が押さえられ、同時に、製造コストを低く押さえることも併せて可能となる。そして、それにもかかわらず、ハーフトーン位相シフトフォトマスクの特長である通常のフォトマスクでは得られない高分解能が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるハーフトーン位相シフトフォトマスクの断面図である。

0 【図2】本発明のハーフトーン位相シフトフォトマスク

特開平5-127361

8

の製造工程の1例を示す断面図である。

【図3】ハーフトーン位相シフトリソグラフィーの原理 を示す図である。

【図4】従来法を示す図である。

【図5】従来のハーフトーン位相シフトフォトマスクの 製造工程示す断面図である。

【符号の説明】

10…石英基板

11…ハーフトーン遮光層兼位相シフト層

3 9 … 基板

40…導電層

41…ハーフトーン遮光層兼位相シフト層

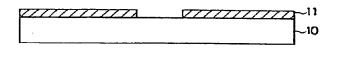
42…電離放射線レジスト

43…レジストパターン

44…エッチングガスプラズマ

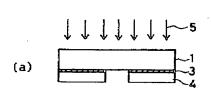
45…ハーフトーン位相シフターパターン

[図2]



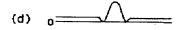
[図3]

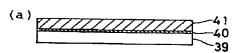
[図1]

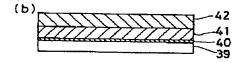


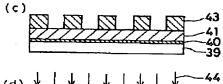


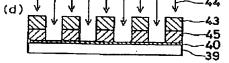


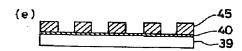




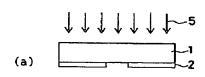








【図4】

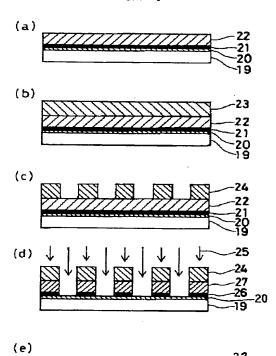








【図5】



		•
	€.	